

a 2013 0062

Invenția se referă la tehnologia semiconductoarelor și poate fi utilizată la fabricarea dispozitivelor de conversie a radiației solare în energie electrică.

Procedeul de creștere a structurii pInP-nCdS, include amplasarea unui substrat de pInP, corodat preventiv, cu orientarea cristalografică (100) și deorientarea de 3...5° în direcția (110) într-un reactor, încălzirea zonei de creștere a substratului și stabilizarea temperaturii în diapazonul de 400...450°C, pulverizarea, în flux deschis de oxigen, a soluțiilor de CdCl₂ și SnCl₄ cu formarea pe substrat a unui strat de Cd₂SnO₄, apoi pulverizarea soluțiilor de CdCl₂ și CS(NH₂)₂ cu formarea pe acesta a unui strat de nCdS.

Revendicări:1